Инверсия поглощения и рассеяния при плазмонном резонансе в наночастицах с металлической оболочкой

© А.И. Сидоров

07

Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова, 199034 Санкт-Петербург, Россия e-mail: aisidorov@newmail.ru

(Поступило в Редакцию 13 декабря 2005 г.)

Представлены результаты численного моделирования оптических свойств сферических наноструктур, состоящих из диэлектрического ядра с поглощением (усилением) и металлической оболочки в условиях плазмонного резонанса. Показано, что уменьшение поглощения в ядре приводит к увеличению сечений поглощения и рассеяния наноструктуры в спектральной области плазмонного резонанса. При наличии в ядре усиления возникает дополнительный резонанс, сопровождающийся изменением характера зависимости сечений поглощения и рассеяния от коэффициента усиления. Рассмотрены условия возникновения такого резонанса.

PACS: 78.67.-n

Композитные среды с наночастицами благородных металлов представляют большой практический интерес при разработке быстродействующих оптических переключателей [1,2]. Линейные и нелинейные оптические свойства таких сред определяются плазмонным резонансом металлических наночастиц и свойствами прозрачной матрицы. При наличии у наночастицы внутренней структуры, например диэлектрического ядра, появляются дополнительные возможности управления ее оптическими свойствами — спектральным положением плазмонного резонанса и характером оптического отклика на внешнее воздействие. Это объясняет большое количество экспериментальных и теоретических исследований таких наноструктур в последние годы [3–5].

При изучении нелинейно-оптических свойств наноструктур с диэлектрическим ядром и металлической оболочкой, как правило, учитывается либо нелинейная восприимчивость металлической оболочки [3], либо нелинейная добавка к показателю преломления материала ядра [5]. В то же время в полупроводниках и диэлектриках существует целый ряд нелинейнооптических эффектов, приводящих к изменению коэффициента поглощения, которые могут быть использованы для управления оптическими свойствами наноструктур ядро-оболочка. Такие эффекты можно разделить на две группы. К первой относятся эффекты, сопровождающиеся увеличением коэффициента поглощения при увеличении интенсивности излучения: двухфотонное поглощение, светоиндуцированный фазовый переход полупроводник-металл [6], обратное насыщающееся поглощение [7]. Ко второй — эффекты, при которых рост интенсивности излучения приводит к просветлению среды: эффект Бурштейна-Мосса [8], насыщение экситонного [9] и примесного поглощений [10]. Кроме того, в полупроводниковом (диэлектрическом) ядре может быть создана инверсия населенности уровней, например, с помощью оптической накачки. В этом случае ядро наноструктуры может обладать усилением.

Данная работа посвящена изучению влияния поглощения (усиления) в ядре сферической наноструктуры типа ядро-оболочка на оптические характеристики плазмонного резонанса. Рассмотрены наноструктуры, размер которых много меньше длины волны, но больше радиуса экситона. Это позволяет пренебречь квантово-размерными эффектами в наноструктуре. При численном моделировании не учитывались спектральная дисперсия коэффициента поглощения (усиления) и изменение показателя преломления. Указанные допущения позволяют четко выделить непосредственный вклад изменения коэффициента поглощения в модуляцию оптических характеристик наноструктуры при плазмонном резонансе.

Сечения поглощения и рассеяния наночастицы с оболочкой описываются следующими выражениями [11]:

$$\sigma_a = \frac{8\pi^2 \sqrt{\varepsilon_h} r_s^3}{\lambda} \operatorname{Im}(\delta), \tag{1}$$

$$\sigma_s = \frac{128\pi^5 \varepsilon_h^2 r_s^6}{3\lambda^4} |\delta|^2. \tag{2}$$

Здесь δ — поляризуемость наночастицы

$$\delta = \frac{\varepsilon_s \varepsilon_a - \varepsilon_h \varepsilon_b}{\varepsilon_s \varepsilon_a + 2\varepsilon_h \varepsilon_b}, \quad \varepsilon_a = \varepsilon_c (3 - 2P) + 2\varepsilon_s P,$$

$$\varepsilon_s = \varepsilon_c + \varepsilon_c (3 - P) \tag{3}$$

$$\varepsilon_b = \varepsilon_c + \varepsilon_c (3 - P),$$
 (3)

$$P = 1 - \left(\frac{r_c}{r_s}\right)^s,\tag{4}$$

 $\varepsilon_h, \varepsilon_c, \varepsilon_s$ — диэлектрическая проницаемость среды, ядра и оболочки соответственно, r_c — радиус ядра, r_s — радиус оболочки, λ — длина волны излучения.

Условием возникновения плазмонного резонанса является обращение в нуль действительной части знаменателя поляризуемости наночастицы [11]:

$$\operatorname{Re}(A) = \operatorname{Re}(\varepsilon_s \varepsilon_d + 2\varepsilon_h \varepsilon_b) = 0.$$
(5)

Численное моделирование проводилось для следующих параметров: показатели преломления среды и ядра — $n_h = 1.5$, $n_c^* = 3.5 - ik$; материал оболочки — серебро (использовались оптические константы серебра из [12] для спектрального интервала $\lambda = 0.8 - 1 \, \mu$ m); радиус ядра и оболочки — $r_c = 0.01$, $r_s = 0.0121 \, \mu$ m.

На рис. 1 показано влияние изменения коэффициента поглощения k в ядре наноструктуры на спектральные характеристики сечения поглощения и рассеяния вблизи плазмонного резонанса. При отсутствии поглощения в ядре плазмонный резонанс приводит к появлению на спектре поглощения и рассеяния наночастицы узких резонансных полос. Увеличение коэффициента поглощения k в ядре наночастицы от 0 до 0.5 приводит к уменьшению сечения поглощения и рассеяния всей наночастицы в спектральном интервале плазмонного



Рис. 1. Спектры сечения поглощения (a) и рассеяния (b) наночастиц с оболочкой из Ад и поглощающим ядром: $I - k_c = 0, 2 - 0.05, 3 - 0.2, 4 - 0.5.$



Рис. 2. Зависимость сечения поглощения (1, 3) и рассеяния (2, 4) наночастиц от коэффициента поглощения: 1, 2 — наночастица с оболочкой из Ад в максимуме плазмонного резонанса; 3, 4 — наночастица без оболочки.

резонанса. Этот эффект сопровождается существенным увеличением спектральной ширины полос поглощения и рассеяния и небольшим сдвигом этих полос в коротковолновую область спектра.

На рис. 2 показаны зависимости амплитуды сечения поглощения и рассеяния наночастицы с оболочкой в максимуме резонанса от коэффициента поглощения в ядре. Для сравнения на рисунке приведены аналогичные зависимости для наночастицы без металлической оболочки. Из рисунка видно, что наибольшее изменение сечения поглощения и рассеяния наночастицы с оболочкой происходит при k < 0.1, причем влияние поглощения в ядре наночастицы в большей степени сказывается на сечении поглощения. При отсутствии у наночастицы металлической оболочки повышение ее поглощения приводит к увеличению сечения поглощения и рассеяния. Изменение к в данном случае очень мало влияет на сечение рассеяния наночастицы: модуляция σ_s наночастицы без оболочки в сотни раз меньше, чем модуляция σ_s наночастицы с оболочкой при одном и том же изменении коэффициента поглощения.

Таким образом, в наночастице с металлической оболочкой, в условиях плазмонного резонанса, происходит инверсия зависимостей сечения поглощения и рассеяния от коэффициента поглощения в ядре по сравнению с наночастицей без оболочки. Описанный эффект имеет простое объяснение — увеличение потерь в резонансной системе приводит к ухудшению условий резонанса, уменьшению его амплитуды и уширению резонансной полосы. Такая инверсия оптических свойств структурированных наночастиц с металлической оболочкой вблизи плазмонного резонанса дает возможность создавать композитные среды с новыми нелинейно-оптическими свойствами: инверсной зависимостью оптического отклика, по сравнению с композитной средой из неструктурированных наночастиц.



Рис. 3. Спектры сечения поглощения (*a*) и рассеяния (*b*) наночастиц с оболочкой из Ад и ядром, обладающим усилением: $I - k_c = 0.06, 2 - 0.08, 3 - 0.09, 4 - 0.1.$

При создании в наночастице инверсии населенностей в ней может возникнуть усиление излучения. Усиление в композитной среде с наночастицами может быть получено, например, с помощью оптической накачки. В этом случае в полупроводниковых наноструктурах могут возникать эффекты, подобные лазерной генерации [13,14]. В связи с этим представляет интерес анализ оптических характеристик сферических наноструктур полупроводник—металл вблизи плазмонного резонанса при наличии усиления в полупроводниковом ядре наноструктуры.

Численное моделирование проводилось для сферических наночастиц, состоящих из полупроводникового ядра, обладающего усилением излучения, и оболочки из металлического серебра. Показатель преломления ядра — $n_c^* = 3.5$, радиус ядра — $r_c = 0.01$, радиус оболочки — $r_s = 0.0121 \,\mu$ m. Наночастицы находятся в среде без поглощения с показателем преломления $n_h = 1.5$.

На рис. З показаны расчетные спектры сечения поглощения и рассеяния наночастиц вблизи плазмонного резонанса при изменении коэффициента усиления ядра kв интервале 0.05–0.1. Видно, что с ростом коэффициента усиления уменьшается ширина полосы плазмонного резонанса и увеличивается ее амплитуда. При $k \approx 0.09$ достигается максимальное сечение поглощения и рассеяния в центре резонанса. Однако при дальнейшем увеличении k происходит резкое сокращение поглощения и рассеяния, причем величина σ_a становится отрицательной. Этот процесс сопровождается увеличением спектральной ширины полосы плазмонного резонанса.

Характер зависимостей $\sigma_a(k)$ и $\sigma_s(k)$ структурированной наночастицы в максимуме плазмонного резонанса иллюстрирует рис. 4. Для сравнения на рисунке показаны аналогичные зависимости для наночастицы без металлической оболочки, видно, что при $k \approx 0.09$ происходит резонансное изменение сечения поглощения и рассеяния наночастиц с металлической оболочкой. При k > 0.09 знак меняется $d\sigma/dk$ на противоположный.



Рис. 4. Зависимость сечения поглощения (*a*) и рассеяния (*b*) наночастиц от коэффициента усиления: *I* — наночастица с оболочкой из Ag в максимуме плазмонного резонанса, *2* — наночастица без оболочки.

Журнал технической физики, 2006, том 76, вып. 10



Рис. 5. Зависимость действительной (2) и мнимой (1) частей знаменателя поляризуемости наночастицы с оболочкой из Ag от коэффициента усиления ядра.

Коэффициент усиления влияет на оптические свойства структурированных наночастиц в значительно большей степени, чем на свойства наночастиц без оболочки. Например, модуляция сечения рассеяния наночастицы с оболочкой более чем в 10^3 раз превышает модуляцию, наночастицы без оболочки при одном и том же изменении k.

Анализ показал, что описанный резонанс возникает при иных условиях, нежели обычный плазмонный резонанс в наночастицах с металлической оболочкой. Условием возникновения обычного резонанса является обращение в нуль действительной части знаменателя поляризуемости наночастицы — $\operatorname{Re}(A) = 0$ (3)-(5). Плазмонный резонанс, рассмотренный выше, возникает при обращении в нуль мнимой части знаменателя поляризуемости — Im(A) = 0 (рис. 5). При соответствующем подборе геометрических параметров наночастицы возможно совмещение двух типов плазмонных резонансов: Re(A) = Im(A) = 0. В этом случае происходит резкое уменьшение спектральной ширины резонансных полос сечения поглощения и рассеяния и увеличение их амплитуды. Необходимо отметить, что возникновение нового типа плазмонного резонанса в структурированной наночастице возможно лишь при очень высоком коэффициенте усиления в ядре. Однако оптимизация геометрических размеров наночастицы, а также диэлектрических проницаемостей ее компонентов позволяет уменьшить величину k, соответствующую резонансу, в 2−3 раза.

Таким образом, оптическая реакция наночастицы с металлической оболочкой на изменение коэффициента поглощения или усиления в ядре, в условиях плазмонного резонанса, существенно отличается от реакции обычной, не структурированной наночастицы. Увеличение поглощения в ядре наночастицы с металлической оболочкой приводит к уменьшению ее сечения поглощения и рассеяния — происходит инверсия оптической реакции по сравнению с обычной наночастицей. При наличии усиления в ядре возможно возникновение нового плазмонного резонанса, приводящего к дополнительной модуляции оптических параметров наночастицы.

Рассмотренные эффекты позволяют расширить возможности создания новых композитных сред с нелинейно-оптическими свойствами для оптических переключателей и модуляторов излучения. При этом могут быть использованы известные нелинейно-оптические эффекты, связанные со светоиндуцированным изменением коэффициента поглощения — двухфотонное поглощение, насыщение экситонного поглощения, эффект Бурштейна-Мосса и др. Достоинством структурированных наночастиц является не только возможность инвертирования оптического отклика, но и увеличение его амплитуды. При использовании наночастиц с ядром, обладающим усилением, появляется возможность создания новых типов светоуправляемых оптических переключателей с чрезвычайно высоким коэффициентом модуляции оптических характеристик.

Работа выполнена при поддержке FGAN-FOM и ISTC (партнерский проект № 3063).

Список литературы

- [1] Chakraborty P. // J. Mater. Sci. 1998. Vol. 33. N 8. P. 2235.
- [2] Hamanaka Y, Nakamura A., Omi S. et al. // Appl. Phys. Lett. 1999. Vol. 74. N 12. P. 1712.
- [3] Averitt R.D., Westcott S.L., Halas N.J. // JOSA B. 1999. Vol. 16. N 10. P. 1814.
- [4] Averitt R.D., Westcott S.L., Halas N.J. // JOSA B. 1999.
 Vol. 16. N 10. P. 1824.
- [5] Gao L. // Phys. Lett. A. 2003. Vol. 318. P. 119.
- [6] Rini M., Cavalleri A., Schoenlein R.W. et al. // Opt. Lett. 2005. Vol. 30. N 5. P. 558.
- [7] Wray J.E., Liu K.C., Chen C.H. et al. // Appl. Phys. Lett. 1994. Vol. 64. N 21. P. 1785.
- [8] Мосс Т., Баррел Г., Эллис Б. Полупроводниковая оптоэлектроника. М.: Мир, 1976. 431 с.
- [9] Kang I., Wise F.W. // JOSA. B. 2000. Vol. 14. P. 1632.
- [10] Сидоров А.И. // Оптич. журн. 2002. Т. 69. № 1. С. 7.
- [11] Neeves A.E., Birnboim M.H. // JOSA B. 1989. Vol. 6. N 4. P. 787.
- [12] Золотарев В.М., Морозов В.Н., Смирнова Е.В. Оптические постоянные природных и технических сред. Справочник. Л.: Химия, 1984. 215 с.
- [13] Zhi-Yuan Li, Kai-Ming Ho // Phys. Rev. B. 2005. Vol. 71. P. 045 315.
- [14] Protsenko I.E., Uskov A.V., Zaimidoroga O.A. et al. // Phys. Rev. A. 2005. Vol. 71. P. 063 812.